4P126

実空間密度汎関数法による表面吸着系の 光学応答量の計算手法の実装

(阪大院基礎工) <u>乾 智也</u>, 奥野 克樹, 馬場 剛史, 米田 京平, 福田 幸太郎, 重田 育照, 中野 雅由

Theoretical study on optical properties of molecules adsorbed on surface based on real-space density functional theory

(Osaka Univ. Graduate School of Engineering Science) <u>Tomoya Inui</u>, Katsuki Okuno, Takeshi Baba, Kyohei Yoneda, Kotaro Fukuda, Yasuteru Shigeta, Masayoshi Nakano

【序】分子にレーザー光のような強い光が照射されると、分子に分極が誘起されるが、その 分極は光電場のべき級数に展開できる。この高次の項に起因して起きる光学現象を非線形光 学応答といい、3 次元光メモリなどへ応用が期待されている。これまで我々の研究室では大 きな第二超分極率を持つ、非線形光学応答特性の優れた様々な分子の設計を行ってきた。従 来の研究ターゲットは単一分子や有限サイズの分子クラスターが主であったが、新たなター ゲットとして環境の効果に着目している。ここでいう環境とは溶液内などの均一場の効果[1] ばかりでなく、表面やケージ内など不均一場の効果も含み、それらが非線形光学特性にどの ような影響を与えるかは非常に興味深い。光学応答は電子のゆらぎである分極に起因してい るため、たとえば分子がある表面系に吸着したような系では電荷移動が起こり光学応答特性 の変化が誘起される。これにより、より優れた光学応答特性をもつ分子の設計、及び光学応 答特性の制御が期待される。

固体表面を対象とする際には二次元の無限系を取り扱う必要がある。表面平行方向に対し ては周期境界条件を用いることで取り扱うことができるが、表面垂直方向には周期性は存在 しない。このような系を取り扱う方法として、クーロンカットオフ法[2]を実空間密度汎関数 (RSDFT)法に実装する。RSDFT 法では空間を有限のグリッドに区切り、有限差分を用いる ことで Kohn-Sham 方程式を解くことから、並列化が容易であるといった利点をもつ。

本研究では表面系での線形・非線形光学応答特性の評価のために、二次元の周期性を持つ 系に対する RSDFT 法プログラムを実装し、固体表面に対して結果の妥当性を検証する。

【理論】クーロンポテンシャルの場合、逆空間でのポテンシャルは3次元周期境界条件下で 以下のように表される。

$$V(\mathbf{G}) = n(\mathbf{G})v^{3D}(\mathbf{G}), \quad v^{3D}(\mathbf{G}) = \frac{4\pi}{G^2}$$

ここで $n(\mathbf{G})$ は電荷密度のフーリエ変換であり、 $\mathbf{G} = (G_x, G_y, G_z)$ は逆空間ベクトルである。こ れに対してクーロンカットオフ法では 2 次元周期系の場合に周期性の無い方向(ここでは *z* 軸方向)のクーロン相互作用が単位胞内で打ち切られるように変更を加えることで 2 次元系 を取り扱う。具体的に、上式の $v^{3D}(\mathbf{G})$ は 2 次元周期において、次のように変更される。

$$v^{2D}(\mathbf{G}) = \begin{cases} \frac{4\pi}{G^2} \left\{ 1 + e^{-G_{xy}(Z/2)} \left[\left(G_z / G_{xy} \right) \sin \left(G_z Z / 2 \right) - \cos \left(G_z Z / 2 \right) \right] \right\} & \left(G_{xy} \neq 0 \right) \\ \frac{4\pi}{G_z^2} \left\{ 1 - \cos \left(G_z Z / 2 \right) - \left(G_z Z / 2 \right) \sin \left(G_z Z / 2 \right) \right\} & \left(G_{xy} = 0 \right) \end{cases}$$

ここで、 $G_{xy} = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ 、Zは単位胞のz軸方向長さである。RSDFT 法のプログラム[3]に上記の2次元クーロンカットオフ法を実装した。また、2次元系のz軸方向に対する分極率・超分極率の取り扱いとして、有限場法を用いた計算法を実装した。ここで、分極率を有限場法で求めるために、z軸方向に外部電場の掛かった計算のためのプログラム変更も同時に行った。

【計算】本研究では交換相関汎関数にPZ81を採用し、 図1の単位胞(赤枠)を用い、xy方向には通常の周期 境界条件を、z軸方向(紙面垂直方向)には前述の方 法を用いることで、2次元グラフェン(以後グラフェ ンと呼ぶ)(a)、一次元グラフェン(グラフェンナノリ ボン; GNR)の1種であるポリアセン(b)の(超)分極率 を算出した。またグラフェン及び GNR との比較のた めにそれぞれ C_6H_6 、 $C_{24}H_{12}$ 、 $C_{54}H_{18}$ 及びポリアセン系 (ベンゼン環数 2–12)の分極率についても算出した。 この計算は交換相関汎関数に PW91、基底関数は 6-31G*を採用しGAUSSIAN09を用いた。

【結果と考察】図2にグラフェン及びその類似分子の 1 炭素原子あたりの分極率を示す。ベンゼンから順に 炭素の数が増えていくに従って1 炭素原子あたりの分 極率はある値に収束していくが、本プログラムの結果 はその値に近い値が得られていることがわかる。図3 は GNR における結果を示している。GNR においても 前述のグラフェンの場合と同様にポリアセン系の分 極率によく一致した結果が得られている。また1 炭素 原子あたりのグラフェン、ポリアセンの第二超分極率 γ はそれぞれ 22.1 および 81.6 a.u.であった。ただしグ ラフェンのγの計算では計算精度などの理由から、単位 助を m 方向に二位に拡大1 た 16 原子の単位的を用い



図 1. 単位胞の概形 (a)グラフェン (L_x =4.648, L_y =8.050, L_z =20.0) (b)GNR (L_x =4.648, L_y =16.10, L_z =20.0)





胞を xy 方向に二倍に拡大した 16 原子の単位胞を用い (n はポリアセン系におけるベンゼン環の数) た。表面吸着系に関する結果は当日報告する。

【参考文献】[1] 乾智也、他、第5回分子科学討論会 [4P105] (2011). [2] C. A. Rozzi et al. *Phys. Rev.* B 73, 205119 (2006). [3] J.-I. Iwata et al., *J. Comp. Phys.* 229, 2339 (2010).